

# NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

ISSUE 2 – APRIL 2002

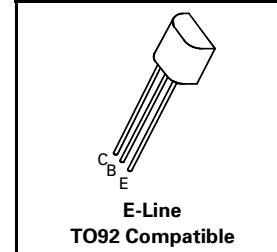
**ZTX658**

## FEATURES

- \* 400 Volt  $V_{CEO}$
- \* 0.5 Amp continuous current
- \*  $P_{tot}=1$  Watt

## APPLICATIONS

- \* Telephone dialler circuits



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	400	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	400	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	1	A
Continuous Collector Current	$I_C$	500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ derate above $25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1 5.7	W mW/°C
Operating and Storage Temperature Range	$T_j:T_{stg}$	-55 to +200	°C

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	400			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	400			V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			100	nA	$V_{CB}=320\text{V}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			100	nA	$V_{CE}=320\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			100	nA	$V_{EB}=4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			0.3 0.25 0.5	V	$I_C=20\text{mA}, I_B=1\text{mA}$ $I_C=50\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$ $I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			0.9	V	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(on)}$			0.9	V	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	50 50 40				$I_C=1\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=200\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$

# ZTX658

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated).

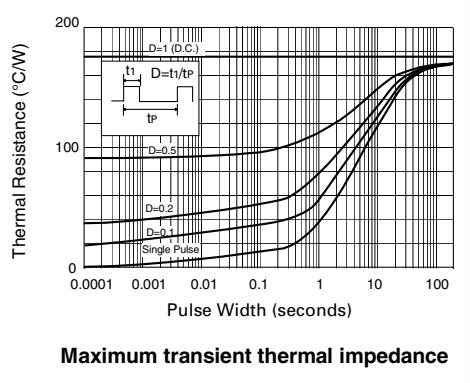
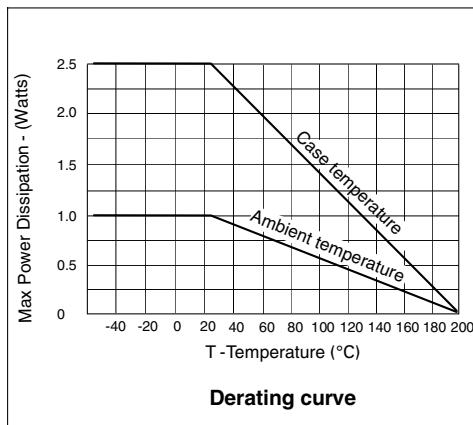
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Transition Frequency	$f_T$	50			MHz	$I_C=20mA, V_{CE}=20V$ $f=20MHz$
Output capacitance	$C_{obo}$			10	pF	$V_{CB}=20V, f=1MHz$
Switching times	$t_{on}$ $t_{off}$		130 3300		ns ns	$I_C=100mA, V_C=100V$ $I_{B1}=10mA, I_{B2}=-20mA$

\* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤2%

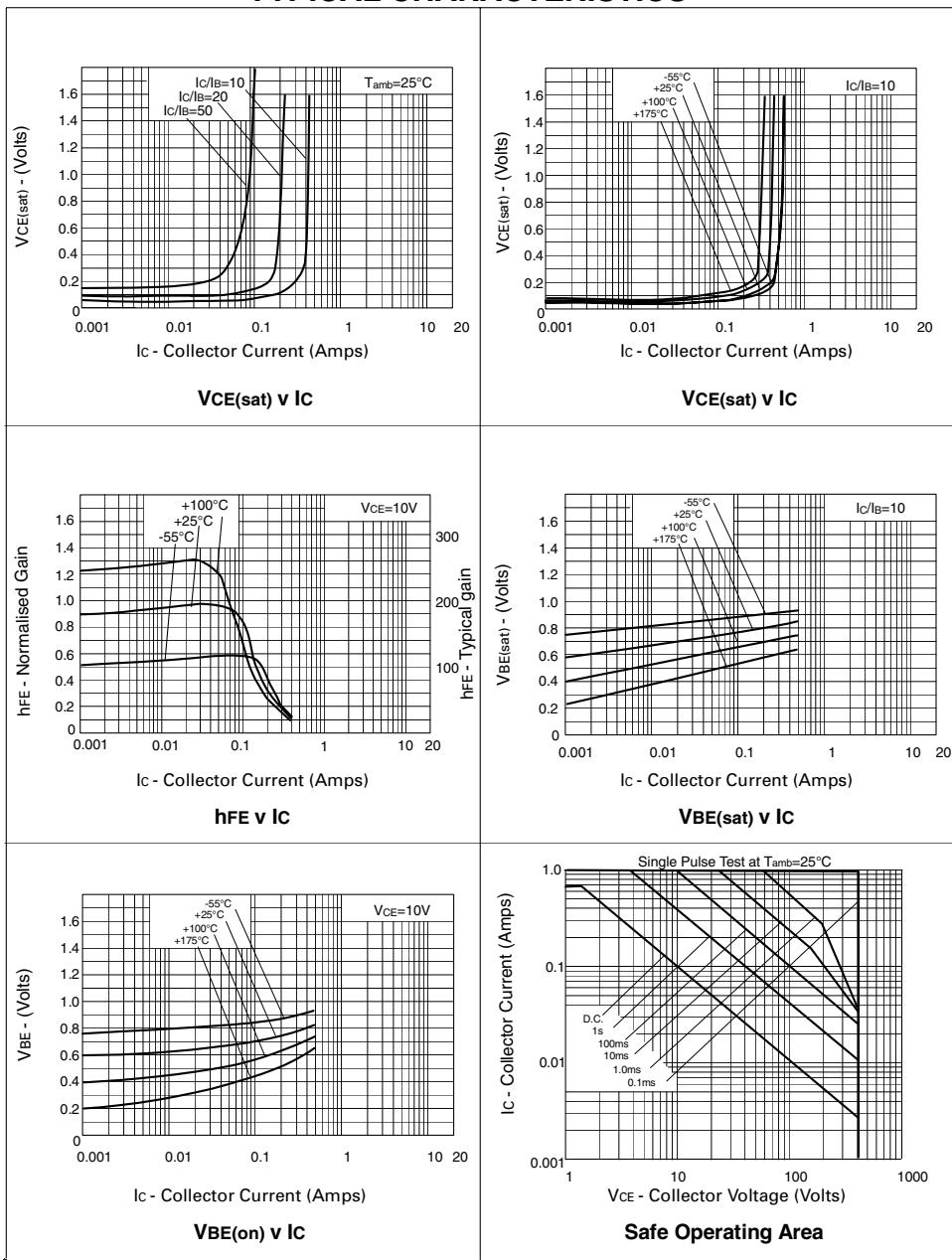
## THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient <sub>1</sub>	$R_{th(j-amb)1}$	175	°C/W
Junction to Ambient <sub>2</sub>	$R_{th(j-amb)2}$ †	116	°C/W
Junction to Case	$R_{th(j-case)}$	70	°C/W

† Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.



## TYPICAL CHARACTERISTICS



**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9